

Кремниевый фотодетекторный чип 960×960 мкм — техническое описание

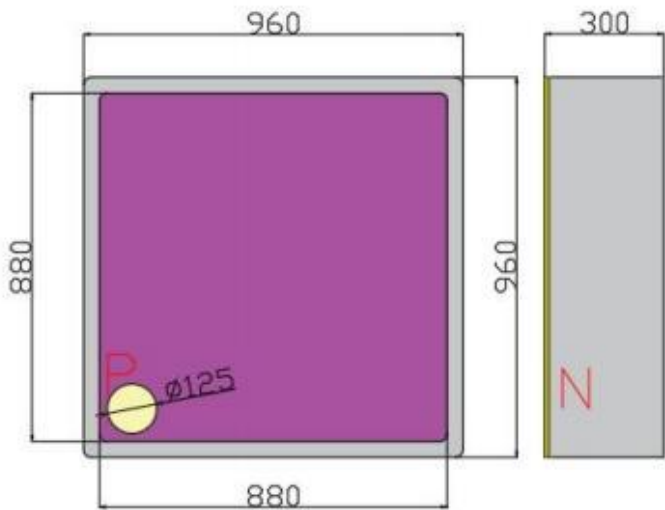
P/N : WS9A-01C

Применение

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод;
электроды: задняя сторона (катод) — Au,
верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	880±10 x 880±10			мкм
Ширина чипа	960			мкм
Длина чипа	960			мкм
Высота чипа	280	300	320	мкм
Размер контактной площадки		125		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100µA, H=0	35			В
Рабочий диапазон длин волн	λp		400	940	1100	нм
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Емкость	Cj	VR=3V, f=1MHz		11		пФ